(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047194 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7: 51/40

- (74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3155,
- (21) Internationales Aktenzeichen:
 - PCT/DE2003/003776

H01L 51/20,

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 53 955.3 19. November 2002 (19.11.2002)

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ROST, Henning [DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen (DE).

- 90014 Nürnberg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen 2. September 2004 Recherchenberichts:

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING THE SAME ORGANIC MATERIAL FOR AT LEAST TWO **FUNCTIONAL LAYERS**

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GLEICHEM ORGANISCHEM MATERIAL FÜR ZUMINDEST ZWEI FUNKTIONSSCHICHTEN

- (57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field effect transistor (OFET), in which a single organic material is used for at least two functional layers, for example as a conductive and semiconductive material. The invention also relates to an efficient method for producing two functional layers, for example source and drain electrodes, in addition to the semiconductive layer, in one process step, for use in organic field effect transistors. The conductive or semiconductive regions in the semiconductive or conductive matrix are obtained for example by doping, e.g. by a partially controlled redox reaction.
- (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material für zumindest zwei Funktionsschichten, beispielsweise als leitendes und als halbleitendes Funktionsmaterial, dient. Außerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfahren, um in einem Prozessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Elektroden sowie die Halbleiterschicht für den Einsatz in organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen. Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden Matrix werden beispielsweise durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell geführte Redoxreaktion erhalten.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ational Application No PCT/DE 03/03776

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L51/20 H01L51/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of t	Relevant to claim No.	
х	DE LEEUW D M ET AL: "Polymericircuits and light-emitting dielectron DEVICES MEETING, 1997 DIGEST., INTERNATIONAL WASHING 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, US, 7 December 1997 (1997-12-0331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 the whole document	1-4	
X	US 5 691 089 A (SMAYLING MICH 25 November 1997 (1997-11-25) column 5, line 19 - column 6,		1-4,7
		-/	
X Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	Y Patent family members are lister	d in annex.
"A" docum consider filing the filing that the	ategories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) enter referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	"T" later document published after the it or priority date and not in conflict will cited to understand the principle or invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot be considered to involve an involve an inventive step when the cannot be considered to involve an document is combined with one or ments, such combination being obtain the art. "&" document member of the same pate	th the application but theory underlying the claimed invention to be considered to document is taken alone a claimed invention inventive step when the more other such documentous to a person skilled
Date of the	actual completion of the International search	Date of mailing of the international s	earch report
1	15 July 2004	22/07/2004	•
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Authorized officer Königstein, C	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No PCT/DE 03/03776

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Retevant to claim No.
DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, XP001051921 TSSN: 0379-6779	1-4
the whole document	8
DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 the whole document	
XIUYING QIAO ET AL: "The FeC1/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document	
KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 the whole document	
WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14) claims 1-5; figure 6	1-8
	1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779 the whole document DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 the whole document XIUYING QIAO ET AL: "The FeC1/sub 3/-doped poly(3-alkyith1ophenes) in solid state" SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAESGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 the whole document WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

leatheattonal Application No PCT/DE 03/03776			
PCT/DE	03/03776		

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5691089	A	25-11-1997	US US US	5567550 A 5677041 A 5942374 A	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999
WO 03067680	Α	14-08-2003	JP WO	2003234473 A 03067680 A1	22-08-2003 14-08-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ntionales Aktenzeichen PCT/DE 03/03776

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L51/20 H01L51/40

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowelt diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

C. ALS WESENT	ICH ANGESEHENE UNTERL	AGEN
---------------	-----------------------	------

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric integrated circuits and light-emitting diodes" ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 7. Dezember 1997 (1997-12-07), Seiten 331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 das ganze Dokument	1-4
X	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25. November 1997 (1997-11-25) Spalte 5, Zeile 19 - Spalte 6, Zeile 50 -/	1-4,7

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
لثا	entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausceführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmektedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht koliidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Täligkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derseiben Patentfamille ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22/07/2004

15. Juli 2004

Bevolimächtigter Bediensteter

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbahörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016

Königstein, C

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In ationales Aktenzeichen PCT/DE 03/03776

A /= :		03/03//6	
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.	
· X	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 69, Nr. 1-3, 24. Juli 1994 (1994-07-24), Seiten 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779	1-4	
Υ	das ganze Dokument	8	
Y	DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 86, Nr. 1-3, 1997, Seiten 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument	8	
A .	XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., Bd. 122, Nr. 2, 1. Juni 2001 (2001-06-01), Seiten 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument		
A	KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 13, Nr. 21, 2. November 2001 (2001-11-02), Seiten 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 das ganze Dokument		
P,X	WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14. August 2003 (2003-08-14) Ansprüche 1-5; Abbildung 6	1-8	

HATEIMAN HOMALLIN INCOMENOMICATION

Angaben zu Veröffentlik

. die zur selben Patentfamilie gehören

In tionales Aktenzelchen			
PCT/DE	03/03776		

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5691089	Α	25-11-1997	US US US	5567550 A 5677041 A 5942374 A	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999
WO 03067680	A	14-08-2003	JP WO	2003234473 A 03067680 A1	22-08-2003 14-08-2003